

「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

# グローバルCOE特別セミナー

日時：平成23年1月12日（水） 16:30-18:30

会場：福井大学産学官連携本部3F研修室

演題：「窒化物半導体界面の

電子準位制御と電子デバイス応用」

講師：橋詰 保先生

北海道大学 教授

Prof. Tamotsu Hashizume

HOKKAIDO UNIVERSITY

## Abstract

窒化物半導体は高効率電力変換デバイスおよび高周波パワーデバイスへの応用研究が急ピッチで展開されているが、MOSゲート構造の達成や高い動作信頼性を得るためには表面・界面電子準位の制御が必須である。

本講演では、半導体表面準位のモデル、電子デバイスに与える影響、統計的取り扱いと評価法、制御法について概説する。

## 問い合わせ先

福井大学大学院工学研究科電気・電子工学専攻  
葛原 正明 TEL: 0776-27-9714(直通)